引用格式:贺琦璐,王一青,黄鹰,等.基于二氧化钒相变材料的光电器件激光防护研究[J]. 信息对抗技术,2023,2(3):44-51.[HE Qilu, WANG Yiqing, HUANG Ying, et al. Research on laser protection of photoelectric devices based on vanadium dioxide phase change material[J]. Information Countermeasure Technology, 2023, 2(3):44-51.(in Chinese)]

基于二氧化钒相变材料的光电器件激光防护研究

贺琦璐^{1,2},王一清¹,黄 鹰^{1*},赖建军^{1*}

(1. 华中科技大学武汉光电国家研究中心,湖北武汉 430074; 2. 中航凯迈(上海)红外科技有限公司,上海 201306)

摘 要随着激光致盲武器的快速发展,与之对应的激光致盲防护技术逐渐成为了一项重要的研究。相变材料二氧化钒(VO₂)因在合适的热、光、场等激励下发生半导体相与金属相的可逆相变导致光学和电学特性的显著变化而受到激光防护领域的持续关注。使用 Drude-Lorentz 模型对 VO₂ 的光学常数进行了研究,针对单层二氧化钒在半导体相红外透过率不够高的问题进行了多层膜设计和优化,并实际制作了多层膜系。使用激光器与傅里叶红外光谱仪测试制备的 VO₂ 薄膜,得到了薄膜的相变与防护效果等性能,验证了 VO₂ 良好的激光致盲防护性能,实际测试表明半导体相的透过率大于 92%,相变前后多层膜系的红外开关率超过 98%。

关键词 激光防护;相变材料;二氧化钒薄膜;硅光电池

 中图分类号
 TN 977
 文章编号
 2097-163X(2023)03-0044-08

 文献标志码
 A
 DOI
 10.12399/j. issn. 2097-163x. 2023. 03. 004

Research on laser protection of photoelectric devices based on vanadium dioxide phase change material

HE Qilu^{1,2}, WANG Yiqing¹, HUANG Ying^{1*}, LAI Jianjun^{1*}

Wuhan National Laboratory for Optoelectronics, Huazhong University of Science and Technology, Wuhan 430074, China;
 China Aviation Kai Mai (Shanghai) Infrared Technology Co., Ltd, Shanghai 201306, China)

Abstract With the rapid development of laser blinding weapons, the technique of laser blinding protection has attracted a surge of interest in the research community. Vanadium dioxide (VO_2) is a phase change material which has attracted continuous attention in the field of laser protection due to the remarkable change of its optical and electrical properties caused by the reversible phase transition between semiconductor phase and metal phase under appropriate heat, light and field excitation. In this paper, the Drude-Lorentz model was exploited to research the optical constants of VO_2 . Design and optimization of vanadium-dioxide based multilayer film were carried out to overcome the shortcoming of low transmittance of semiconductor phases of single-layer VO_2 . Lasers and a fourier infrared spectrometer were adopted to evaluate the characteristics and protective effects of the prepared VO_2 film, which verified the promising performance of VO_2 for laser blinding protection. Experimental measurement shows that the transmittance of semiconductor phase is greater than 92%, and the infrared switching ratio of multilayer film system before and after the phase transition is more than 98%.

Keywords laser protection; phase transition material; VO₂ film; silicon photocell

0 引言

激光武器是利用高亮度激光束携带的巨大 能量摧毁或杀伤敌方飞机、导弹、卫星、车辆和 人员等目标的高技术新概念定向能武器。它可 以用来实现硬杀伤(对目标壳体或部件进行直 接破坏),也可以用来实现软杀伤(对光学系统、 光电器件进行干扰或致盲,使之在一定时间里 丧失探测功能[1-2])。目前用于光学系统和光电 传感器的激光防护技术主要有光谱滤波技术、 光学限幅技术和光学开关技术[3-5]。光谱滤波技 术需要知道激光的波长,再根据波长针对性设 计光学薄膜或结构来反射、散射或衍射激光,属 于波长防护型技术;光学限幅技术是利用强光 与物质的非线性相互作用原理使透射激光光强 限制在一定水平以下的技术,属于具有宽谱响 应的光强型防护型技术;光学开关技术也是基 于非线性光学原理,在激光光强达到一定阈值 时光学薄膜的透射率发生开关状的突变导致激 光被反射回去从而保护探测装置,同样属于具 有宽谱响应的光强型防护型技术。光学限幅和 光学开关2种技术均具有一定的智能响应 特性[6]。

一种常用的光学开关技术是基于二氧化钒 (VO₂)薄膜材料。VO₂ 是一种相变材料,当温度 低于 68 ℃时, VO₂ 为单斜 M 相呈绝缘体(半导 体)态;温度高于 68 ℃时, VO2(R)为四方金红石 结构相的金属性质材料;相变前后电阻率可相差 3~5个数量级。同时,相变前后光学特性也发生 较大的变化,特别是在中长波红外波段。在低于 相变温度时,红外光对单层 VO2 薄膜的透过率可 以达到 60%以上;而当温度高于 68 ℃时,红外光 的透过率急剧减小到10%以下。除了少量吸收 外,大部分红外光将被反射,表明 VO₂ 具有良好 的红外开关特性,因而可用于红外光学系统和光 电器件的激光防护^[7]。美国 Westinghouse 公司 成功研制了一种以 VO2 为主的激光防护膜,用以 保护卫星上的光学探测系统免受激光武器的干 扰和破坏^[8]。国内对于 VO₂ 作为防护材料应用 于激光防护中的研究相对于国外起步较晚,但是

近些年来也取得了许多成果。如脉冲功率激光 技术国家重点实验室的路远等用 CO2 脉冲激光 验证了 VO₂ 具有保护探测器的作用,能够在激光 对器件造成损伤前有效地保护 HgCdTe 红外探 测器^[9]。中国科学院可再生能源重点实验室利用 等效介质理论设计并实际制备了一种 VO₂-SiO₂ 复合薄膜,有效提高了可见波段 VO₂ 的透过率。 相对于单一 VO2 薄膜在可见光波段平均 29.6% 的透过率, VO₂-SiO₂复合薄膜将可见光波段的 透过率提升到了 48.5%,同时 VO2 相变前后红 外波段透过率仍有一定的变化^[10]。如华中科技 大学通过优化退火温度得到了高质量 VO2 防护 薄膜,在3.6 μm 波长处,相变前防护薄膜透过率 为77%,相变后薄膜的透过率为5%,红外开关率 达 94%^[11];哈尔滨工业大学研究的 VO₂ 薄膜,在 CO2 激光作用下,相变前半导体态的透过率为 70.8%,相变后降低到 11.3%^[12]。新近的探索包 括基于超表面或频率选择表面等表面微纳结构 的谐振模式实现宽带高开关率的限幅目标的 研究^[13-14]。

虽然 VO₂ 具有智能激光防护的潜力,但是实际应用还要解决低温相光学透射率不高、开关率不足、相变阈值较高和损伤阈值不高等问题。这些问题除了与 VO₂ 物化结构有关外,还与其制备工艺有关。制备 VO₂ 薄膜的主要方法包括化学气相沉积法、溶胶-凝胶法、脉冲激光沉积法以及溅射沉积法。使用不同工艺制备的 VO₂ 薄膜的特性会存在一定的差异。本文采用反应离子束溅射沉积与后退火工艺两步法制备 VO₂ 薄膜^[9]。之后对实际制备的 VO₂ 薄膜椭偏参数测试,并结合色散模型曲线的拟合获得 VO₂ 薄膜在红外波段的光学常数,然后采用多层膜优化设计增透膜系,获得高开关率的红外相变开关,最后将该开关用于近红外和中波红外激光的激光防护实验,验证膜系的激光防护性能。

1 多层薄膜材料的设计和制作

单层 VO₂ 薄膜制备工艺简单,但是低温相透 过率低,不能满足实际应用要求。例如厚度为 80 nm 的单层 VO₂ 薄膜在 3~5 μm 红外窗口区 的低温平均透过率低于 80%,高温平均透过率约 为 8%。虽然可以通过减小薄膜厚度来提高信号 光透过率,但是如果厚度小于 80 nm,由于吸收较 小,薄膜高温平均透过率较大,在有致盲激光攻 击时无法达到较好的防护效果。此外,实验发现 厚度较小的薄膜在实际制备中均匀性较差。因 此,实用的方法是设计多层膜系以提高低温透过 率,减少高温透过率。

1.1 VO₂ 薄膜的光学常数

设计防护膜系时需要用到 VO₂ 的复折射率。 通常使用 Drude-Lorentz 色散模型来描述 VO₂ 材料的介电常数与入射光子能量的关系^[15]:

$$\epsilon(E) = \epsilon_{\infty} - \frac{E_{p_1}^2}{E^2 + iE/\tau_1} - \sum_{j=2}^4 \frac{E_{p_j}^2}{E^2 - E_{0j}^2 + iE/\tau_j}$$
(1)

式中, $\epsilon(E)$ 代表材料的介电函数;第一项 ϵ_{∞} 是高 频介电常数;第二项 $\frac{E_{P1}^2}{E^2+iE/\tau_1}$ 是标准 Drude 模 型,与材料的自由载流子有关,E₂表示等离子体 频率, τ 表示自由载流子碰撞时间; 第三项是考虑 了能带间电子跃迁的谐振子模型, E_{pi} 表示谐振 子频率, E_{0i} 表示共振的能量, τ_i 表示谐振子碰撞 时间。文献[15]分别给出了光子能量大于 1.2 eV 和小于 1.2 eV 中两段曲线对应的色散参 数值和光学常数。由于具体制备工艺和材料的 不同,文献中得到的 VO₂ 的光学常数往往差异较 大,因此需要对实际制作的 VO₂ 薄膜进行测量求 得精确的光学常数。通常获得光学常数的方法 为通过椭圆偏振光谱仪测量实际制备 VO₂ 薄膜 的椭偏参数,然后结合上述的色散模型拟合反演 确定介电常数 ϵ ,进而得到光学常数:折射率 n 和 消光吸收 k。

本文实验采用反应离子束溅射沉积与后退 火工艺两步法制备 VO₂ 薄膜^[9]。反应离子束溅 射设备为美国 Denton 公司的 HDG 系统。实验 所用靶材为金属钒靶,纯度达 99.95%;溅射气体 为 Ar,纯度达 99.999%;反应气体为 O₂,纯度达 99.999%。基底选择直径为 5.08 cm,厚度为 400 μm 的蓝宝石片(c-Al₂O₃)。设备可加热并旋 转基底,增加沉积薄膜的均匀度。后退火工艺使 用真空管式高温烧结炉,型号为 OTF-1200X,设 备炉膛是由高纯度氧化铝微晶纤维经过高温真 空吸附制备成型的,内炉膛表面涂有耐 1 750 ℃ 高温的涂层材料。该设备可在真空或者多种气 氛状态下对金属、非金属及其他化合物进行退火 处理,使用 N₂ 作为退火气氛。

由于缺少红外椭偏仪,本文首先使用工作 在可见光-近红外波段(244~1649 nm)的椭偏 仪进行 VO2 薄膜椭偏参数的测量,在获得色散 参数后,再外推到 3~5 μm 波段,得到其在中波 红外的光学常数。实际测量采用美国 JA Woollam 公司的 RC2 型光谱椭偏仪获得椭偏光学参 数,而薄膜的各种光学常数经由椭偏仪自带的 软件 CompleteEASE 对数据进行拟合后计算得 到。通过椭偏仪得到被测样品的 p 偏振与 s 偏 振反射光之间的振幅比例和相位差数据,分别 由 ψ 和 Δ 表示。然后采用 Drude-Lorentz 色散模 型对测得的 ϕ 和 Δ 数据进行拟合计算。在拟合 过程中, ϕ 和 Δ 的实验测得值被用来同拟合模 型预测值进行比较,拟合模型中的各种参数则 通过不断的变化和调整使实验测得值同拟合模 型预测值之间的差别尽可能的小,该差值通过 定义如下的均方差(mean square error, MSE)来 量化描述:

 $\varphi_{\mathrm{MSE}} =$

$$\sqrt{\frac{1}{2N-M}\sum_{i=1}^{N}\left[\left(\frac{\psi_{i}^{\text{Mod}}-\psi_{i}^{\text{Exp}}}{\sigma_{\psi,i}^{\text{Exp}}}\right)^{2}+\left(\frac{\Delta_{i}^{\text{Mod}}-\Delta_{i}^{\text{Exp}}}{\sigma_{\Delta,i}^{\text{Exp}}}\right)^{2}\right]}$$
(2)

式中,N 是测量时 ϕ 和 Δ 对的数量,M 是模型中 拟合变量的数量, σ 代表每次测量时实验标准偏差,上标"Mod"和"Exp"分别代表模型拟合和实 验测量。 φ_{MSE} 越小表明拟合结果的准确度越高, 本文得到的 $\varphi_{MSE} < 1$ 。

图 1 所示为在可见光-近红外波段通过椭偏 仪得到的椭偏参数与拟合曲线的软件显示界面。 外推得到低温相 VO₂ 的中波红外光学常数,如图 2 所示。由图 2 可见,实际制备的薄膜复折射率 n与 k 拟合值分别约为 2.87 与 0.09,与文献[13] 中得到的 n 与 k 值 (n = 3.16、k = 0.07)存在差 异,但是该曲线在 3~5 μ m 波段的变化趋势与该 文献基本一致,即随着波长增加,n 值先逐渐增加 后趋于稳定,而 k 值则逐渐减小。在高温下的光 学常数则与文献[13]中的差异不明显。



图 1 显示椭偏参数和模型拟合曲线的椭偏仪测试软件界面







1.2 多层膜系的设计

获得 VO₂ 的红外光学常数后,采用 TFCalc 光学薄膜设计软件设计应用于红外衬底上 VO₂ 薄膜在 3~5 μm 波段的多层增透膜,目的是提高 无致盲激光攻击时信号光的低温透过率。选择 厚度为 0.4 mm 的蓝宝石玻璃作为中波红外衬底 材料。VO2 薄膜参数设置为低温相变前的复折 射率,使用连续优化目标对透过率进行目标设 置,优化波段略大于防护波段,设置为2.8~ 5.2 μm。用设置可变材料以及计算等效膜堆的 方法,先对可变材料的厚度和折射率进行优化, 再用计算等效膜堆功能用高低 2 种折射率材料来 替换可变材料。有高低高(HLH)折射率和低高 低(LHL)折射率 2 种替换方式。替换材料在考 虑了折射率、透明波段以及制备方法等因素后选 择了锗(Ge)、硒化锌(ZnSe)、氟化钇(YF3)材料。 优化设计的宽带增透膜系结构如图3所示。



图 3 蓝宝石衬底两侧增透膜系的组成结构示意图

Fig. 3 Schematic diagram of composition of anti-reflection film system on both sides of sapphire substrate



图 4 含有单层 VO2 薄膜以及多层增透膜系蓝宝石片的 高低温态透过率曲线



在优化的膜系结构下,得到的高低温红外透 过率如图4所示。从图中可以看出,在蓝宝石两 侧加入增透膜后,3~5 μ m的低温红外透过率明显增加,高温透过率虽然也有少许增加,但是仍在一个较低的范围内。多层增透膜片的低温平均透过率(T_i)由单层 VO₂ 薄膜时的 48.80%提高为多层的 93.19%,高温平均透过率(T_h)为 1.13%,红外开关率定义为 $K = (T_i - T_h)/T_i$,因此 K = 98.79%。在 3~5 μ m 红外窗口区,设计的多层增透膜达到了预期的低温平均透过率大于 90%且红外开关率大于 95%的要求。

1.3 膜系制备和测试

首先用得到的最佳工艺参数在蓝宝石基底 上制备厚度为 200 nm 的 VO₂ 薄膜,工艺参数如 下:离子束溅射工艺中 O₂ 流量为 1.2 sccm,基底 温度为 200 ℃,溅射时间 80 min;退火工艺中 N₂ 流量为 30 mL/min,退火温度为 520 ℃,退火时间 为 2 h。然后根据设计的膜系结构,在衬底有 VO₂ 薄膜的一侧使用 Ge、ZnSe、YF₃ 2 种材料镀 制 4 层增透膜,另一侧使用 ZnSe、YF₃ 2 种材料镀 制 7 层增透膜。多层增透膜的制备采用型号为 ZZS700 的电子束蒸发镀膜机。该设备可用膜厚 控制仪对膜厚进行实时监控,各层薄膜厚度根据 仿真值设置。

膜系制作完成后,采用傅里叶红外光谱仪测 试其红外透过率。傅里叶红外挂光谱仪型号为 Thermo Nicolet NEXUS FI-IR,光谱分辨率为 0.09 cm⁻¹。同时测试单层 VO₂ 薄膜的红外透过 率,以便与膜系测试片进行对比。

2 实验结果与讨论

2.1 膜系测试结果

图 5 为增透前后薄膜片的红外透过率曲线, 在 3~5 μ m 波段内,单层 VO₂ 薄膜片的低温态透 过率平均值为 54.24%,含有增透膜片的低温态 透过率平均值为 92.66%,3~5 μ m 波段内的低 温态透过率平均值提高了 38.42%。用 70 ℃的 云母片加热增透膜,在 3~5 μ m 波段内,高温态 下膜 片 的 平 均透 过 率 为 1.40%,开 关 率 为 98.49%。表 1 为仿真与实际制备的多层增透膜 片在红外窗口区的平均透过率对比。可以看到, 实际制备多层膜片的高低温红外透过率与仿真 结果基本一致,说明实际制备的多层膜片的每 层薄膜的厚度与设计的误差较小,达到了仿真 的设计要求。





表 1 仿真与实际制备的多层增透膜 3~5 μm 波段平均透过率对比表

Tab. 1 Comparison of average transmittance of $3 \sim 5 \ \mu m$ band of simulated and actual multilayer anti-reflection film

	低温态 透过率(%)	高温态 透过率(%)	开关率 (%)
多层宽带增 透膜(仿真)	93.19	1.13	98.79
多层宽带增 透膜(制备)	92.66	1.40	98.49

2.2 近红外激光防护实验

为验证 VO₂ 薄膜对红外激光的防护效果,选 择价廉的硅光电池作为光电探测器代表,进行近 红外激光防护实验。搭建如图 6 所示的实验测试 装置。激光光源使用内置准直装置的 1.08 μm 激光器,输出激光光斑半径为 3 mm,最大功率为 30 W,脉冲宽度为 180 ns。为防止 VO₂ 薄膜相变 后突然增大的反射光对激光器造成损伤,入射光 不垂直入射到防护薄膜表面,而是与防护薄膜有 小角度的倾斜,反射光用挡光板遮挡,硅光电池 的输出电压用万用表测量。

根据图 7 的测试结果, 无 VO₂ 防护薄膜时, ab 段曲线硅光电池的输出电压随入射光功率的 增加而增加, 硅光电池正常工作, 当激光功率达 到 1.328 W 时, 硅光电池两端电压开始下降, 当 入射光功率达到 2.217 W 时, 硅光电池两端电压 突然大幅下降, 说明此时达到了硅光电池的损伤 阈值。有 VO₂ 防护薄膜时, de 段硅光电池正常 工作, ef 段硅光电池两端电压减小, 说明此时达 到了 VO₂ 薄膜相变阈值, 相变阈值约为 5.84 W/cm², fg 段硅光电池仍正常工作。光功 率增加到 26.347 W时, VO₂ 薄膜上出现白斑, 硅 光电池两端电压突然下降,说明达到了 VO₂ 薄膜 的损伤阈值,薄膜损伤阈值约为 93.18 W/cm²。 测试结果表明,VO₂ 防护薄膜的加入使硅光电池 的损伤阈值提高了约 11.8 倍。



Fig. 6 Setup schematic of laser protection of silicon photocell



图 7 有无防护膜时硅光电池的输出电压 随激光功率变化曲线

Fig. 7 Variation of output voltage of silicon photocell with laser power or without protective film

2.3 中红外激光防护测试

设计了如图 8 所示的中红外激光测试装置来 验证优化后的多层增透膜的激光防护作用效果。 激光器波长为 3.7 μm,功率在 0~8.73 W 范围内 可调,脉宽为 180 ns,激光重复频率为 12 kHz。 激光经过聚焦透镜后入射到防护膜系,透过防护 膜系的红外光功率用红外探测器测试。

用刀口法测出的激光光斑半径约为 0.16 cm。测出光斑大小后,将防护膜系放置在 原刀口法测试装置的位置,使防护膜系上的光斑 与刀口法测量的光斑大小相同。图9为激光防护 实验的测试结果,大图为使用 Logistic 曲线拟合 的透过率-激光功率曲线,内嵌图为使用高斯拟合 的差分曲线。初始激光功率1.06 W,对应的透过 率为93.01%,随着激光功率的增加,防护膜系的



(a) 中红外激光测试系统

(b) 刀口法测试装置

图 8 红外激光防护效果测试装置 Fig. 8 Setup for evaluation of the effect of protection film against infrared laser radiation 透过率由于 VO₂ 的相变而逐渐降低,相变结束后 防护膜系的透过率降低至 1.35%,红外开关率为 98.55%,与图 5 中的傅里叶红外光谱仪结果以及 设计值基本一致。高斯拟合曲线的极小值对应 的激光功率在增加功率与降低功率时分别为 2.041 W 与 1.536 W,因此增加功率与降低功率 时的相变阈值分别为 25.39 W/cm² 与 19.11 W/cm²。 这说明实际制备的多层增透膜在 3.7 μ m 处兼具 信号光的接收与激光防护功能。





Fig. 9 Transmission of protective film varies with mid-infrared laser power

3 结束语

本文首先基于 Drude-Lorentz 模型计算了 3~5 µm 红外窗口区的 VO2 光学常数,用椭偏仪 测试得到了实际制备薄膜的低温态光学常数。 接着用膜系仿真软件 TFCalc 设计了一种宽带多 层增透膜,解决了无致盲激光攻击时单层 VO2 薄 膜在 3~5 μm 红外窗口区信号光透过率低的问 题,优化后的膜系低温平均透过率由 48.80%提 高为 93.19%,信号光透过率在 3~5 µm 较宽波 段内有明显提高。在获得高低温透过率的基础 上, 开展了将 VO2 膜系用于针对近红外激光和 中红外激光防护的实验研究。对硅光电池的近 红外激光防护验证实验表明,防护膜系可以大大 提高硅光电池的损伤阈值。另外,通过对中红外 激光经过 VO2 膜系后的相变和开关特性的测试, 表明低温透过率高,而高温红外开关率也得到大 大提高,对红外探测器的防护应用具有一定的参 考价值。

参考文献

 [1] 乔凯,高超,高秀娟,等.光学遥感卫星的激光威胁及防护体制探讨[J]. 航天返回与遥感, 2021, 42(2): 59-67.

QIAO Kai, GAO Chao, GAO Xiujuan, et al. Discussion on the laser threat and protection system for optical remote sensing satellites[J]. Sacescraft Recovery & Remote Sensing, 2021,42(2): 59-67. (in Chinese)

- [2] 李振华.激光武器在无人机反制中的发展趋势[J]. 武警学院学报,2021,37(10): 34-38.
 LI Zhenhua. Development trend of laser weapons in UAV countermeasures[J]. Journal of the Armed Police Academy, 2021, 37(10): 34-38. (in Chinese)
- [3] 程立,童忠诚,柳旺季. 国外激光武器的发展现状与趋势[J]. 舰船电子对抗,2019,42(2):56-58.
 CHENG Li, TONG Zhongcheng, LIU Wangji. Present status and tendency of foreign laser weapon[J].
 Shipboard Electronic Countermeasure, 2019, 42(2): 56-58. (in Chinese)
- [4] 马德跃,李晓霞,郭宇翔,等.非线性高能激光防护材料 研究进展[J].激光与红外,2014,44(6):593-599.
 MA Deyue, LI Xiaoxia, GUO Yuxiang, et al. Research progress in nonlinear protective materials against high energy laser[J]. Laser and Infrared, 2014, 44(6): 593-599. (in Chinese)
- [5] 姜百汇,马春勋.光电制导武器的激光致盲防护技术
 [J].飞航导弹,2009(1):21-25.
 JIANG Baihui, MA Chunxun. Laser blinding protection technology for photoelectric guided weapons[J].
 Aerodynamic Missile Journal, 2009(1):21-25. (in Chinese)
 [6] 郑佳艺,马壮,高丽红. 智能化高能激光防护材料新进
- [6] 郑佳乙,马杠,高帆红. 賀能化高能激尤防护材料新进展[J].现代技术陶瓷,2020,41(3):121-133. ZHENG Jiayi, MA Zhuang, GAO Lihong. Development of intelligent anti-high power laser materials[J]. Advanced Ceramics, 2020,41(3):121-133. (in Chinese)
- [7] HUANG Z L, CHEN S H, LV C H. et al. Infrared characteristics of VO₂ thin films for smart window and laser protection applications[J]. Applied Physics Letters, 2012, 101:191905.
- [8] 付伟. 激光防护技术及发展现状[J]. 航天电子对抗, 2002(1): 43-46.

FU Wei. Laser protection technology and development status [J]. Aerospace Electronic Countermeasures, 2002(1): 43-46. (in Chinese)

[9] 路远,凌永顺,冯云松,等. 二氧化钒薄膜对红外脉 冲功率激光的智能防护分析[J]. 红外与激光工程, 2012, 41(11): 2886-2890.

LU Yuan, LING Yongshun, FENG Yunsong, et al. Analysis of VO₂ thin film intelligent protection against pulsed power infrared-laser [J]. Infrared and Laser Engineering, 2012, 41(11): 2886-2890. (in Chinese)

- [10] ZHAO L, MIAO L, LIU C, et al. Solution-processed VO₂-SiO₂ composite films with simultaneously enhanced luminous transmittance, solar modulation ability and anti-oxidation property[J]. Scientific Reports, 2014, 4: 7000.
- [11] XIAO X Y Y, SU D, CHENG Q, et al. The VO₂ thin film of highly optical switching rate for laser protection in infrared detector [C]//Proceedings of Advanced Spectroscopy and Applications. [S. l. : s. n.], 2017: 127-135.
- [12] 田雪松.用于抗激光致盲的氧化钒薄膜制备及光学相 变特性研究[D].哈尔滨:哈尔滨工业大学,2008.
 TIAN Xuesong. Study on anti-laser-damage vanadium oxide thin films's preparation and optical phase transition character[D]. Harbin: Harbin Institute of Technology, 2008. (in Chinese)
- [13] HOWES A, ZHU Z H, CURIE D, et al. Optical limiting based on Huygens' metasurfaces[J]. Nano Letters, 2020, 20: 4638-4644.
- [14] WAN C H, ZHANG Z, SALMAN J, et al. Ultrathin broadband reflective optical limiter[J]. Laser & Photonics Reviews, 2021, 15(6): 2100001.
- [15] GIANNETTI C. Dynamics of non-equilibrium states in solids induced by ultrashort coherent pulses [D]. Kentucky:Brescia University, 2004.

作者简介

女,1996年生,硕士研究生,研究方向 为激光防护技术 E-mail:h13006380103@163.com



王一清 女,1998 年生,硕士研究生,研究方向 为薄膜设计和制备技术 E-mail;yiqing_wang09@163.com



黄 鹰

男,1962年生,博士,教授,博士研究生 导师,研究方向为相变材料及应用 E-mail:hying@hust.edu.cn

赖建军

男,1968年生,博士,研究员,研究方向 为光电材料与器件 E-mail:jjlai@hust.edu.cn

责任编辑 钱 静

51